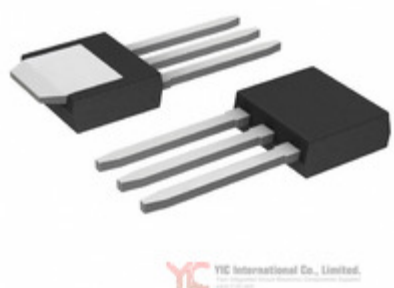


	<h2 style="color: #E67E22;">GP2M005A050PG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP2M005A050PG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK
Datenblätter:	 GP2M005A050PG.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 7100 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	GP2M005A050PG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7100 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	98.4W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	645pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP2M005A050PG ist neu im Original, Suche GP2M005A050PG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP2M005A050PG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP2M005A050PG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>GP2M004A065HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 4A TO220</p>	 <p>GP2M005A050FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A TO220F</p>	 <p>GP2M005A060FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A TO220F</p>	 <p>GP2M005A060CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A DPAK</p>
 <p>GP2M005A060PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK</p>	 <p>GP2M005A060HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A TO220</p>	 <p>GP2M005A050HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A TO220</p>	 <p>GP2M004A065PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 4A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ GP200E1M-G1	↔ GP200E1MTR-G1	⇒ GP200EMTR-G1	D GP200MTR-G1	↔ GP2A231LRSA
⊣ GP2A25J0000F	⊗ GP2A25J0000F	D GP2A25NJ	⇒ GP2A28A1J00F	↔ GP2A28N1J00F
⊗ GP2AP002A00F	⊣ GP2AP002S00F	⊗ GP2AP003A10F	↔ GP2AP007A00F	↔ GP2AP008T00F
D GP2AP030A00F	⊗ GP2AP052A00F	⊣ GP2AP052A00F	⊗ GP2L26K2	↔ GP2M002A060FG
⇒ GP2M004A060PG	↔ GP2M004A065FG	⊗ GP2M004A065PG	⊣ GP2M005A060CG	↔ GP2M005A060FG
↔ GP2M005A060PGH	⇒ GP2M008A060FGH	D GP2M010A060F	⊗ GP2M010A065F	⊣ GP2M011A090NG
⊗ GP2M012A080NG	D GP2M020A050H	⇒ GP2M020A060N	↔ GP2S24J0000F	↔ GP2S27T3
⊣ GP2S27T3J00F	⊗ GP2S27V6	↔ GP2S29SVJ00F	⇒ GP2S40JJ000F	↔ GP2S700HCP
⊗ GP2S700HCP	⊣ GP2W0004YP	⊗ GP2W0110YPS	D GP2W0112YPOF	↔ GP2W0118YPS
↔ GP2W0150YP0F	⊗ GP2W3104XP0F	⊣ GP2W3104YP0F	⊗ GP2W3106YP0F	↔ GP2W3152YP0F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited